三～七の二　［略］

八　回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が一秒以下のもの及び当該エンコーダ用に設計されたリング、ディスク又はスケール

八の二～九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ　［略］

ロ　次のいずれかの機能を持つもの

（一）・（二）　［略］

（三）　デジタル化されたデータを処理するもの

十一　［略］

十二　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

イ～ハ　［略］

ニ　次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　［略］

（二）　次のいずれかに該当するもの

1　一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの

2　周波数マスクトリガー機能を有するものであって、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの

［削る］

十三～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ　結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　七五ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満のシリコン以外の膜を形成するように設計又は改造したもの

（二）・（三）　［略］

ロ～ヌ　［略］

十八　次のいずれかに該当するものの多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板（ニに該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のP型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。）

イ～ニ　［略］

十九～二十二　［略］

三～七の二　［略］

八　回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が一秒以下のもの

八の二～九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ　［略］

ロ　次のいずれかの機能を持つもの

（一）・（二）　［略］

（三）　デジタル化されたデータを解析するもの

十一　［略］

十二　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

イ～ハ　［略］

ニ　次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　［略］

（二）　一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの

ホ　周波数マスクトリガー機能を有するものであって、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えることができるもの

十三～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ　結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　七五ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満のシリコン以外の膜を形成できるもの

（二）・（三）　［略］

ロ～ヌ　［略］

十八　次のいずれかに該当するものの多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板

イ～ニ　［略］

十九～二十二　［略］